

ສົຣີໂໜົດ ຈຶ່ງຄາວຮອນ : ພລຂອງການເຮັງຕົວໃນຮະບນອັດລອຍຂອງສາຮກິ່ງຕົວນຳກຸມ III-V:
ກາຮື້ກາຍາເຊີງທຸນົມືແລະເຊີງຄໍານວນ (EFFECTS OF ORDERING IN III-V SEMICONDUCTOR
ALLOY SYSTEMS: A THEORETICAL AND COMPUTATIONAL STUDY)
ອາຈານຍົກປະການ : ດຣ. ຫຼິມປິຈຳ ລິມປິຈຳນັກ, 174 ນໍາ.

ວິທານີພິນຮົນໄດ້ສຶກຍາຄຸມສົມບັດຂອງສາຮກິ່ງຕົວນຳພສນ໌ສາມຫາຕຸແລະສີ່ຫາຕຸ ໂດຍວິທີ
ແຈກແຈງໂດຍຕຽງ ໂດຍພິຈານາຽຸປະບົບຕ່າງໆ ຂອງການຈັດເຮັງຕົວຂອງຫາຕຸພສນ ໃນແບບຈຳລອງ
ທາງທຸນົມື ກາຍໄດ້ຂາດຂອງເໜລີ່ຫ່ວຍທີ່ກໍາທັນດ ໄດ້ທຳການສຶກຍາຄຸມສົມບັດຂອງສາຮພສນ
ໃນໂຄຮງສ້າງແລ້ວນີ້ໂດຍວິທີພັດງານສັກຍີເທື່ອມເຊີງເອມພົມຄັດ ແລະວິທີຝຶກ໌ຂັ້ນນັດຂອງຄວາມໜາແນ່ນ
ໄດ້ທຳການທົດສອບຄວາມຖຸກທີ່ອະນຸຍາດຂອງຕົວແປຣສົມຂອງພັດງານສັກຍີເທື່ອມເຊີງເອມພົມຄັດສໍາຮັບຮະບນ
ສາຮພສນ ໂດຍປະເປີຍເທື່ອນັບກັບການຄໍານວນແບບເຟັດຕົກນີ້ເພີ້ມໃຈ່ ທີ່ແສດງໃຫ້ເຫັນຄົງຄວາມສອດຄລ້ອງ
ກັນ ທີ່ນີ້ໄດ້ທຳການສຶກຍາໂຄຮງສ້າງອີເລີກທອນນິກສົ່ງສາຮພສນເຈື້ອຈາງ AlGaAs ແລະ GaInP ໂດຍການ
ແຈກແຈງຮູ່ປ່າງຂອງເໜລີ່ທຸກແບບໂດຍຕຽງ ແລະກາຮື້ຍາຮູ່ປ່າງຂອງເໜລີ່ຫ່ວຍທີ່ມີຂາດເລີກ ເພື່ອ
ຈຳລອງການເຮັງຕົວແບບກຸມ ພບວ່າການຄົດຂອງແນບພັດງານແລະກາເພີ້ມຂອງມວລຍັງພລ ຈະເກີດເບື້ນ
ໃນການເຮັງຕົວຂອງໜູ່ເປົ່ວແຕກທີ່ໃນນາງທີ່ກາງ ແນບພັດງານໃນສາຮພສນສີ່ຫາຕຸ AlGaInP ນັ້ນ
ເບື້ນກັບການເຮັງຕົວແບບກຸມ ພບວ່າເບື້ນກັບອົງກົງປະກອບຂອງສາຮພສນອ່າງນາງ ແຕ່ເບື້ນກັບການເຮັງຕົວແບບກຸມໄອອຸນ
ເພີ້ມເລີກນ້ອຍ ໄດ້ແສດງຂອບເບື້ດຂອງແນບພັດງານແບບຕຽງ ໃນປະເງິມຂອງອົງກົງປະກອບຂອງສາຮພສນ
ໄດ້ແນະນຳວິທີການຕຽບສອນອົງກົງປະກອບຂອງສາຮພສນ ໂດຍເຫດຜົນກິດລື່ອງຮັງສີເອກະໜີ

ສາຂາວິชาຟິລິກສົ່ງ
ປຶກການສຶກຍາ 2550

ລາຍມືອ້ອັນນັກສຶກຍາ ຂົງໂຮງ ຂັງກາງຮອນ
ລາຍມືອ້ອັນອາຈານຍົກປະການ ຫຼິມປິຈຳ ລິມປິຈຳນັກ
ລາຍມືອ້ອັນອາຈານຍົກປະການ ນາງສິດສິນ

SIRICHOK JUNGTHAWAN : EFFECTS OF ORDERING IN III-V
SEMICONDUCTOR ALLOY SYSTEMS: A THEORETICAL AND
COMPUTATIONAL STUDY. THESIS ADVISOR : PROF. SUKIT
LIMPIJUMNONG, Ph.D. 174 PP.

SEMICONDUCTOR ALLOYS/DIRECT ENUMERATION

In this thesis, the properties of ternary and quaternary alloys are studied using direct enumeration approach by considering a large number of the arrangements of the constituent elements in theoretical model within a specified size of the unit cell. The empirical pseudo potential method (EPM) and the density functional theory are used to study the properties of alloys in these configurations. The validity of EPM for alloys is tested against first-principles calculations and a reasonable agreement is obtained. The electronic band structures of dilute AlGaAs and GaInP alloys are also studied. The alloy configurations are generated up to desired concentration by direct enumerating all possible cell shapes and by expanding the cell shape already found in smaller cell to simulate the cluster-like configurations. The bandgap reductions and increasing effective masses are observed in superlattice ordering in some specific directions. The bandgaps of AlGaInP are found to depend strongly on the arrangement of the cations. The type of the bandgap (direct or indirect) is found to depend strongly on the alloy composition but only weakly on the cation arrangement. The domains in the alloy composition space for the direct and indirect bandgaps are identified. The analysis of alloy composition using x-ray absorption spectroscopy is suggested.

School of Physics

Academic Year 2007

Student's Signature Sirichok Jungthawan

Advisor's Signature Sukit Limpijumnong

Co-advisor's Signature Miseon Kim